








	<h2>SI1072X-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1072X-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V SC89</p> <p>Datenblätter:  SI1072X-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 99000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1072X-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V SC89
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	99000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 236mW (Ta) Surface Mount SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Verlustleistung (max)	236mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	93 mOhm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI1072X-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1072X-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1072X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1072X-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1073X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 0.98A SC89-6</p>	 <p>SI1072X-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V SC89</p>	 <p>SI1071X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 0.96A SC89-6</p>	 <p>SI1071X-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 0.96A SC89-6</p>
 <p>SI1073X-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 0.98A SC89-6</p>	 <p>SI1072X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 1.3A SOT563F</p>	 <p>SI1072X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 1.3A SOT563F</p>	 <p>SI1077X-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V SC89-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI1056X-T1-GE3	↔ SI1056X-T1-GE3	⇒ SI1058X-T1-GE3	D SI1058X-T1-GE3	⇒ SI1065X-T1-E3
⊕ SI1065X-T1-E3	⊕ SI1065X-T1-GE3	D SI1065X-T1-GE3	⇒ SI1067X-T1-E3	⇒ SI1067X-T1-E3
⊕ SI1067X-T1-GE3	⊕ SI1067X-T1-GE3	⊕ SI1069X-T1-E3	↔ SI1069X-T1-E3	⇒ SI1069X-T1-GE3
D SI1069X-T1-GE3	⊕ SI1070X-T1-E3	⊕ SI1070X-T1-E3	⊕ SI1070X-T1-GE3	⇒ SI1070X-T1-GE3
⇒ SI1071X-T1-GE3	↔ SI1071X-T1-GE3	⊕ SI1072X-T1-E3	⊕ SI1072X-T1-E3	⇒ SI1072X-T1-GE3
↔ SI1073X-T1-GE3	⇒ SI1073X-T1-GE3	D SI1120-A-GMR	⊕ SI1132-A10-GMR	⊕ SI1133-AA00-GMR
⊕ SI113DP-T1-GE3	D SI1141-A10-GMR	⇒ SI1142-A11-GMR	↔ SI1143-A11-GMR	⇒ SI1143-M01-GMR
⊕ SI1144-AAGX-GMR	⊕ SI1300BDL-T1-E3	↔ SI1300BDL-T1-E3	⇒ SI1300BDL-T1-GE3	⇒ SI1300BDL-T1-GE3
⊕ SI1300DL	⊕ SI1300DL-T1	⊕ SI1300DL-T1-GE3	D SI1301DL	⇒ SI1301DL-T1
↔ SI1301DL-T1-E3	⊕ SI1301DL-T1-GE3	⊕ SI1301DL-T1/LGW	⊕ SI1302DL	⇒ SI1302DL-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited